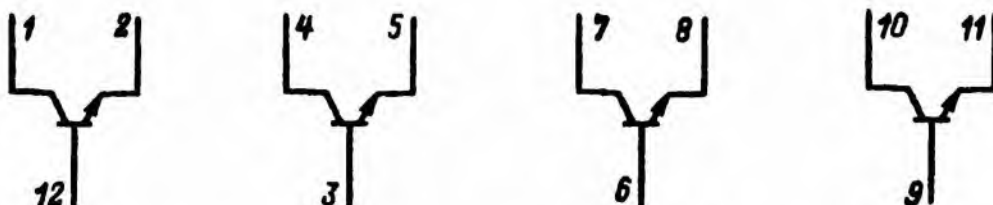


K217HT1, K217HT2, K217HT3

Микросхемы представляют собой сборку из четырех *n-p-n* транзисторов. Корпус штырьковый с 13 выводами.



Электрическая схема K217HT1, K217HT2, K217HT3

Назначение выводов: 1 — коллектор VT1; 2 — эмиттер VT1; 3 — база VT2; 4 — коллектор VT2; 5 — эмиттер VT2; 6 — база VT3; 7 — коллектор VT3; 8 — эмиттер VT3; 9 — база VT4; 10 — коллектор VT4; 11 — эмиттер VT4; 12 — база VT1.

Электрические параметры

Напряжение коллектор — эмиттер	≤ 10 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер	≤ 0,33 В
Ток коллектора	≤ 20 мА
Обратный ток коллектора	≤ 1 мкА
Рассеиваемая мощность одного транзистора	≤ 20 мВт
Коэффициент передачи по току:	
K217HT1	30...90
K217HT2	50...150
K217HT2	70...280
Время рассасывания	≤ 25 нс